

**PNP Silicon AF Transistors**

- For AF driver and output stages
- High collector current
- Low collector-emitter saturation voltage
- Complementary types: BCP54 ... BCP56 (NPN)
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q101



Type	Marking	Pin Configuration						Package
		1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	
BCP51	*	1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	SOT223
BCP51-16	*	1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	SOT223
BCP52-16	*	1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	SOT223
BCP53-10	*	1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	SOT223
BCP53-16	*	1=B	2=C	3=E	4=C	-	-	SOT223

\* Marking is the same as type-name

**Maximum Ratings**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	$V_{CEO}$		V
BCP51		45	
BCP52		60	
BCP53		80	
Collector-base voltage	$V_{CBO}$		
BCP51		45	
BCP52		60	
BCP53		100	
Emitter-base voltage	$V_{EBO}$	5	
Collector current	$I_C$	1	A
Peak collector current, $t_p \leq 10$ ms	$I_{CM}$	1.5	
Base current	$I_B$	100	mA
Peak base current	$I_{BM}$	200	
Total power dissipation- $T_S \leq 120^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	2	W
Junction temperature	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	$T_{stg}$	-65 ... 150	

**Thermal Resistance**

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point <sup>1)</sup>	$R_{thJS}$	$\leq 15$	K/W

<sup>1</sup>For calculation of  $R_{thJA}$  please refer to Application Note AN077 (Thermal Resistance Calculation)

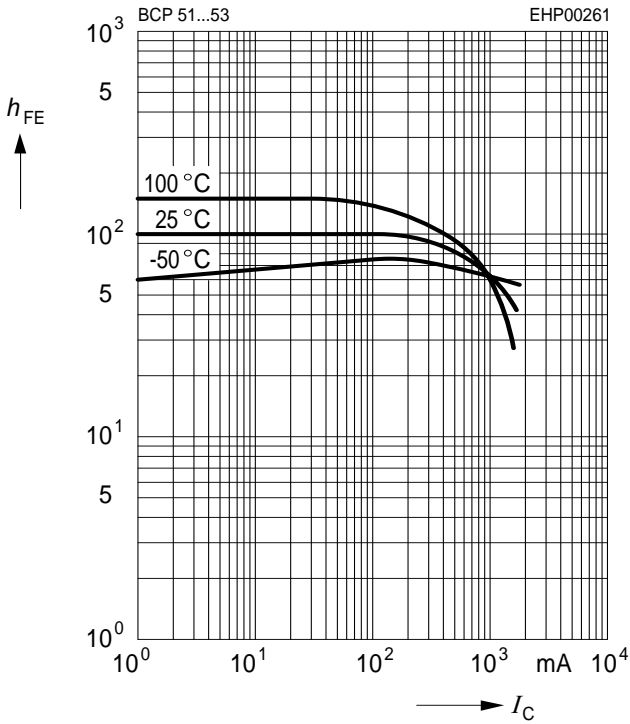
**Electrical Characteristics at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>DC Characteristics</b>					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\text{ mA}$ , $I_B = 0$ , BCP51	$V_{(BR)CEO}$	45	-	-	V
$I_C = 10\text{ mA}$ , $I_B = 0$ , BCP52		60	-	-	
$I_C = 10\text{ mA}$ , $I_B = 0$ , BCP53		80	-	-	
Collector-base breakdown voltage $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$ , $I_E = 0$ , BCP51	$V_{(BR)CBO}$	45	-	-	
$I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$ , $I_E = 0$ , BCP52		60	-	-	
$I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$ , $I_E = 0$ , BCP53		100	-	-	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$ , $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$	5	-	-	
Collector-base cutoff current $V_{CB} = 30\text{ V}$ , $I_E = 0$ $V_{CB} = 30\text{ V}$ , $I_E = 0$ , $T_A = 150^\circ\text{C}$	$I_{CBO}$	-	-	0.1 20	$\mu\text{A}$
DC current gain <sup>1)</sup> $I_C = 5\text{ mA}$ , $V_{CE} = 2\text{ V}$ $I_C = 150\text{ mA}$ , $V_{CE} = 2\text{ V}$ , BCP51 $I_C = 150\text{ mA}$ , $V_{CE} = 2\text{ V}$ , BCP53-10 $I_C = 150\text{ mA}$ , $V_{CE} = 2\text{ V}$ , BCP51-16...BCP53-16 $I_C = 500\text{ mA}$ , $V_{CE} = 2\text{ V}$	$h_{FE}$	25 40 63 100 25	- - 100 160 -	- 250 160 250 -	-
Collector-emitter saturation voltage <sup>1)</sup> $I_C = 500\text{ mA}$ , $I_B = 50\text{ mA}$	$V_{CEsat}$	-	-	0.5	V
Base-emitter voltage <sup>1)</sup> $I_C = 500\text{ mA}$ , $V_{CE} = 2\text{ V}$	$V_{BE(ON)}$	-	-	1	
<b>AC Characteristics</b>					
Transition frequency $I_C = 50\text{ mA}$ , $V_{CE} = 10\text{ V}$ , $f = 100\text{ MHz}$	$f_T$	-	125	-	MHz

<sup>1)</sup>Pulse test:  $t < 300\mu\text{s}$ ;  $D < 2\%$

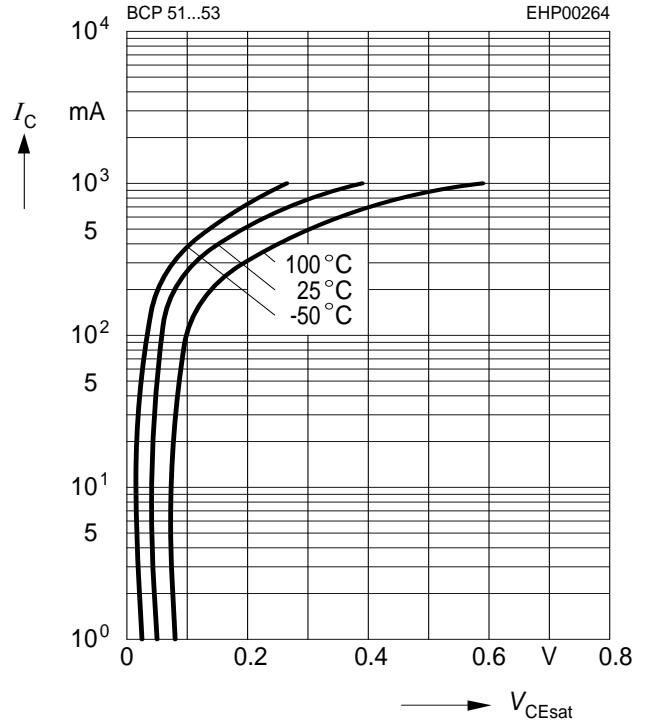
**DC current gain  $h_{FE} = f(I_C)$**

$V_{CE} = 2\text{ V}$



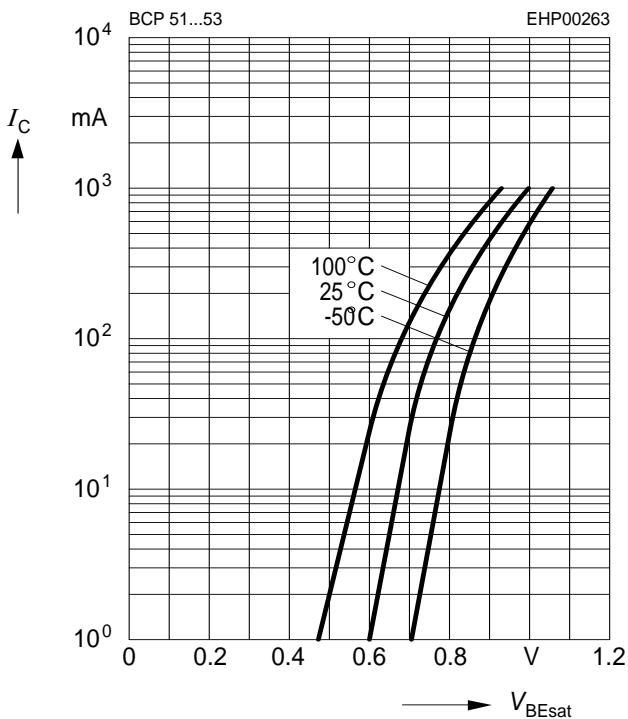
**Collector-emitter saturation voltage**

$I_C = f(V_{CEsat}), h_{FE} = 10$



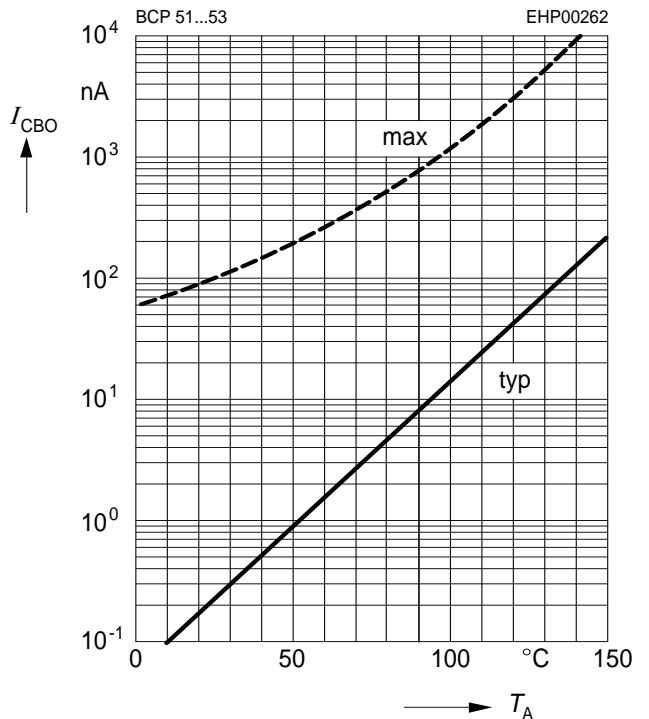
**Base-emitter saturation voltage**

$I_C = f(V_{BEsat}), h_{FE} = 10$



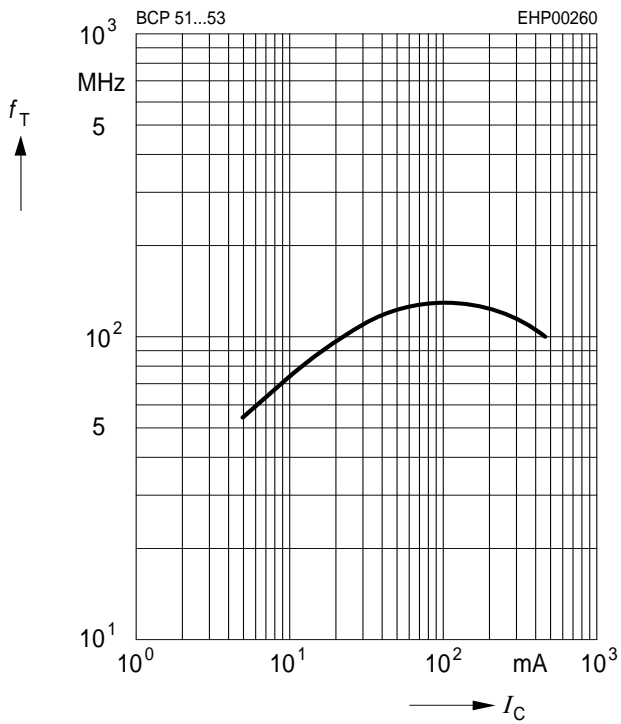
**Collector cutoff current  $I_{CBO} = f(T_A)$**

$V_{CBO} = 30\text{ V}$

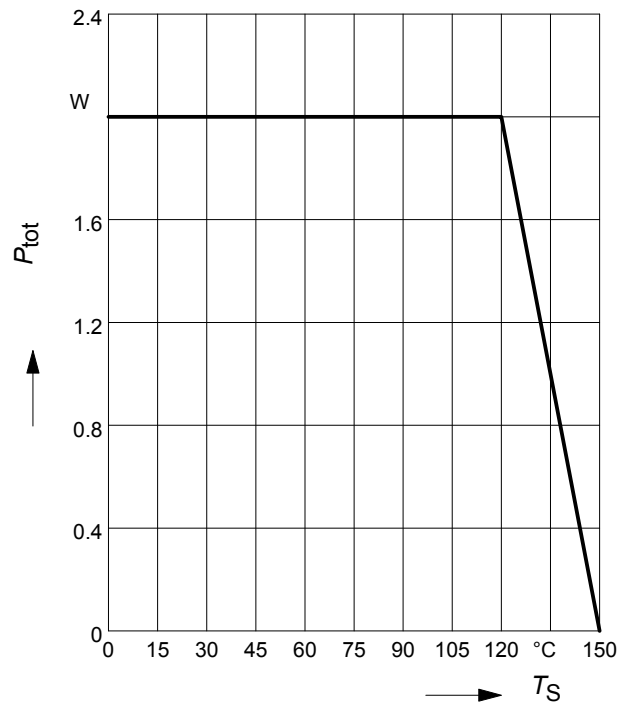


Transition frequency  $f_T = f(I_C)$

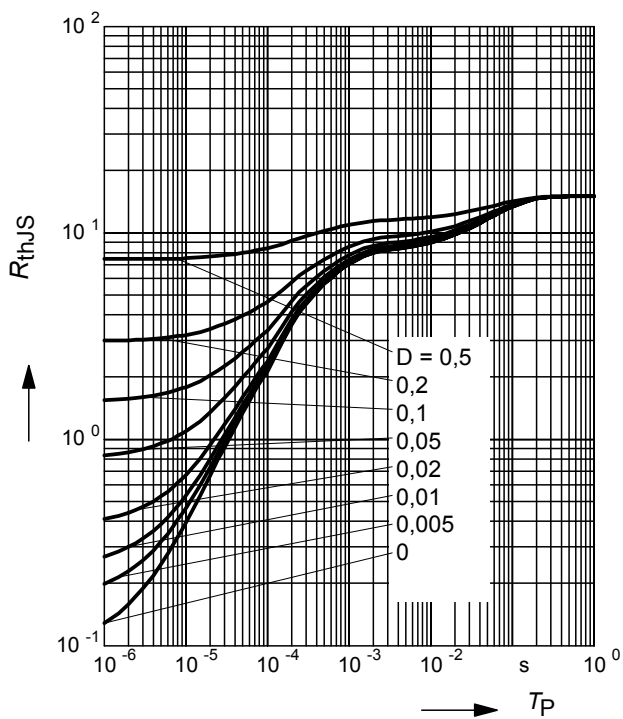
$V_{CE} = 10\text{ V}$



Total power dissipation  $P_{tot} = f(T_S)$

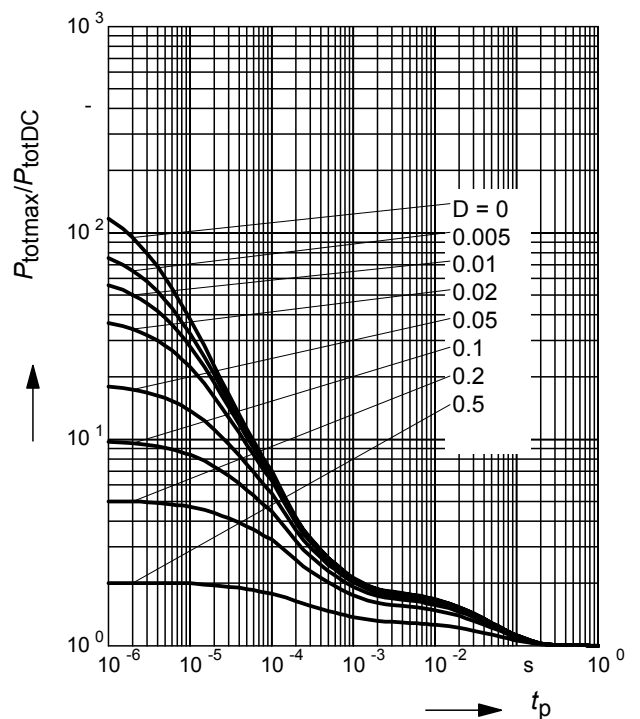


Permissible Pulse Load  $R_{thJS} = f(t_p)$

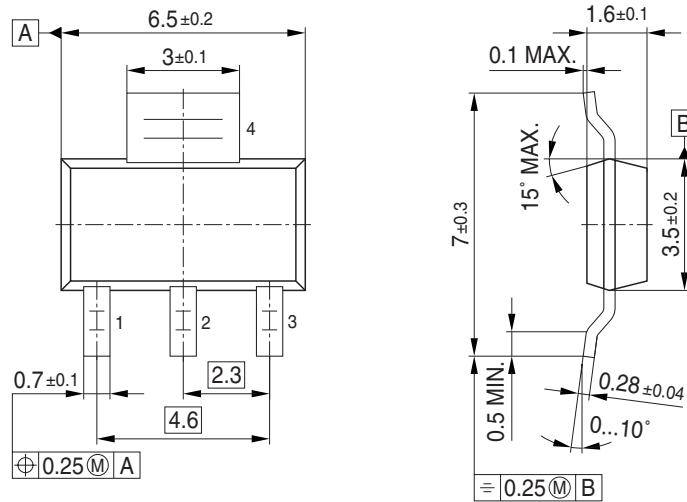


Permissible Pulse Load

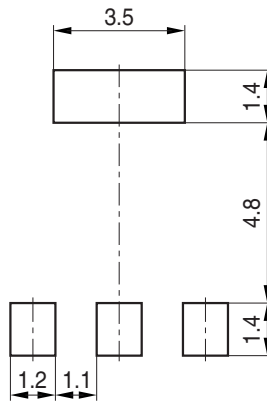
$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$



Package Outline



Foot Print

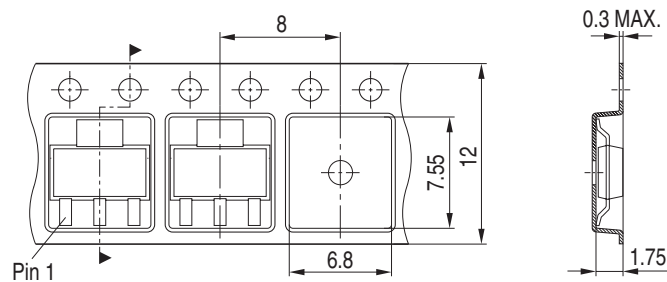


Marking Layout (Example)



Packing

Reel  $\varnothing 180$  mm = 1.000 Pieces/Reel  
 Reel  $\varnothing 330$  mm = 4.000 Pieces/Reel



**Edition 2009-11-16**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG  
All Rights Reserved.**

### **Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

### **Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

### **Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331